

2SB75H

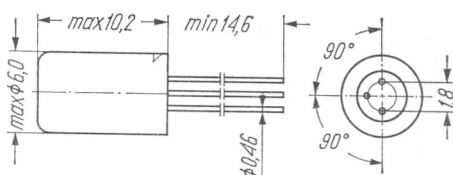
Typ tranzystora: tranzystor germanowy

Firma: HITACHI

Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy *p-n-p*, w obudowie metalowej TO-1

Zastosowanie: wzmacniacze małych sygnałów o częstotliwości akustycznej, wolne układy przełączające

Typy podobne: OC71 (Ph), AC151-V (Sie), GC116/117 (RFT)



Rys. 1-1214. 2SB75H

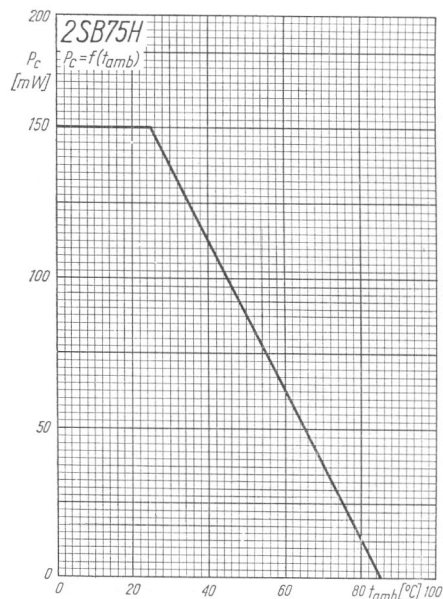
Wartości charakterystyczne¹⁾

	min	typ	max		
I_{CBX}		-6	-10	μA	przy $U_{CB} = -30$ V, $U_{EB} = -6$ V
I_{CEO}		-0,4	-1,0	mA	przy $U_{CE} = -30$ V, $R_{BE} = \infty$
I_{EB0}		-4	-6	μA	przy $U_{EB} = -12$ V, $I_C = 0$
h_{21E}	45	60	80		przy $U_{CE} = -1$ V, $I_C = -50$ mA
h_{11e}		1,6		k Ω	} przy $U_{CE} = -6$ V, $I_E = 1$ mA, $f = 270$ Hz
h_{12e}		3,0		10^{-4}	
h_{21e}		55			
h_{22e}		23		μS	
f_{h21b}		1,2		MHz	przy $U_{CB} = -6$ V, $I_E = 1$ mA
h_{11e}		90			przy $U_{CE} = -6$ V, $I_E = 1$ mA, $f = 10$ MHz
C_{22b}		52		pF	przy $U_{CB} = -6$ V, $I_E = 0$, $f = 1$ MHz
t_d		0,35		μs	} przy $U_{CC} = -12$ V, $I_C = 10I_{B1} = -10I_{B2} = -50$ mA, $R_L = 230 \Omega$, $R_B = 1,2$ k Ω
t_s		1,6		μs	
t_r		2,1		μs	
t_f		1,4		μs	
F		7		dB	przy $U_{CE} = -6$ V, $I_E = 1$ mA, $f = 1$ kHz, $f = 100$ Hz, $R_g = 500 \Omega$

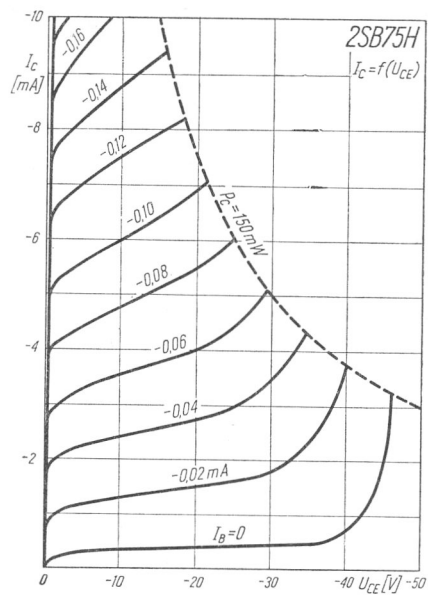
Wartości graniczne

U_{CB0} max	-30	V
U_{CES} max	-30	V
U_{CEO} max	-30	V
U_{EB0} max	-12	V
I_C max	-100	mA
I_E max	100	mA
P_{tot} max	150	mW
t_j max	85	$^{\circ}C$
t_{stg}	-55 ÷ +85	$^{\circ}C$

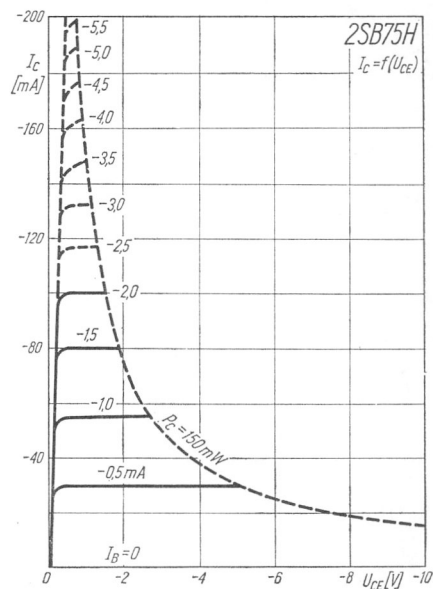
¹⁾ $t_{amb} = 25^{\circ}C$



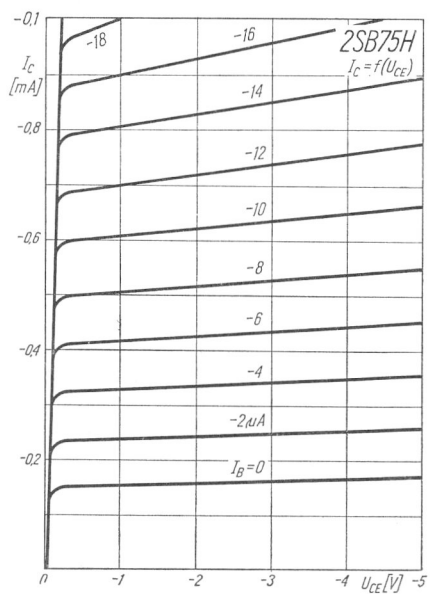
Rys. 1-1215. Zależność dopuszczalnej mocy strat od temperatury otoczenia



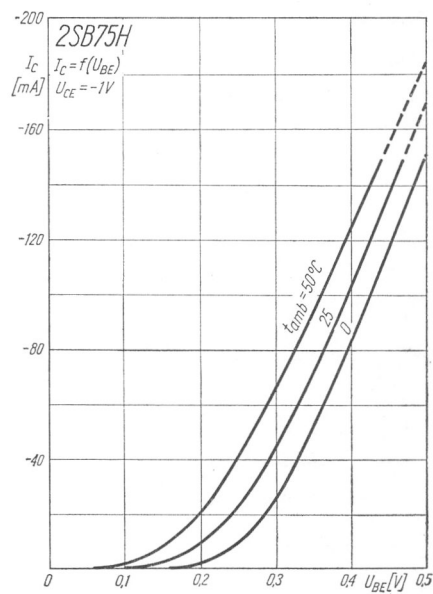
Rys. 1-1216. Charakterystyki wyjściowe



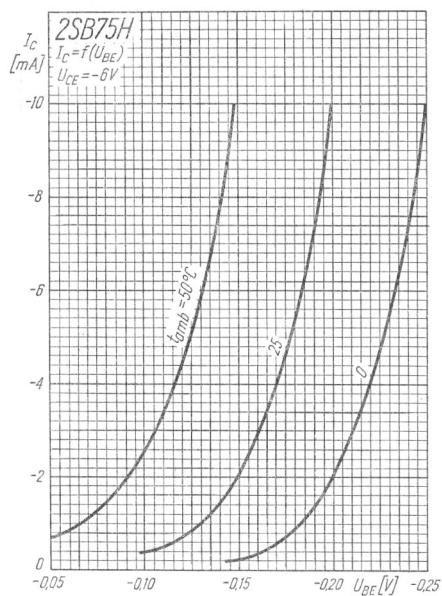
Rys. 1-1217. Charakterystyki wyjściowe



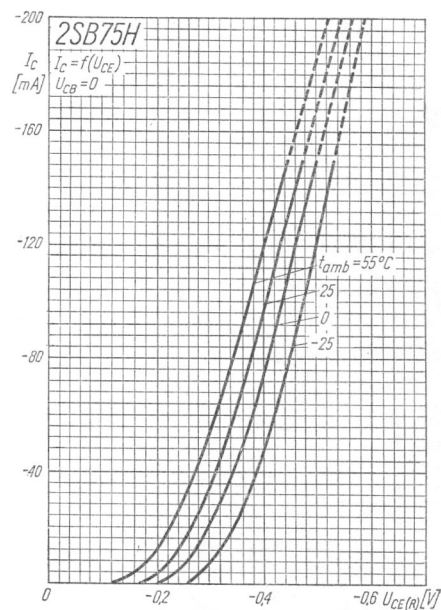
Rys. 1-1218. Charakterystyki wyjściowe



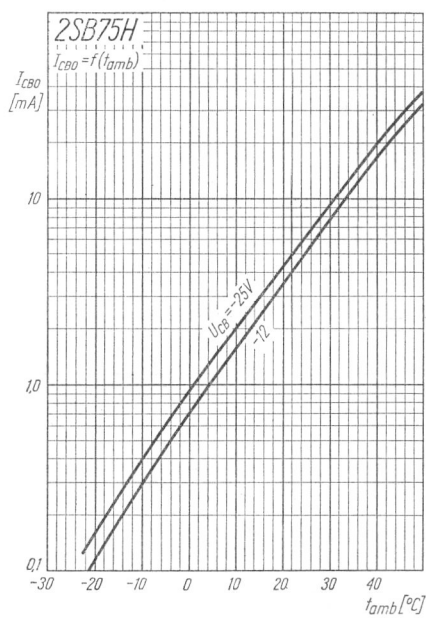
Rys. 1-1219. Charakterystyki sterowania napięciowego



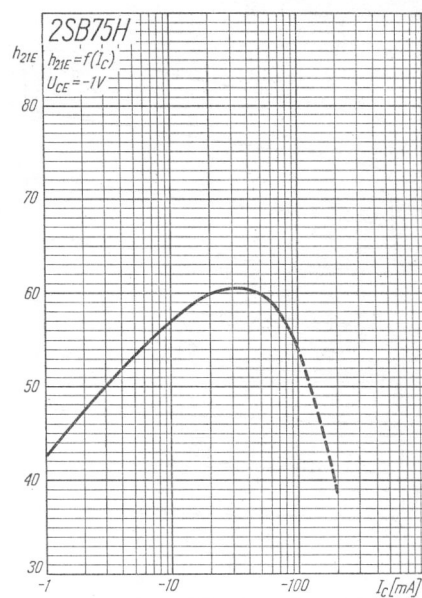
Rys. 1-1220. Charakterystyki sterowania napięciowego



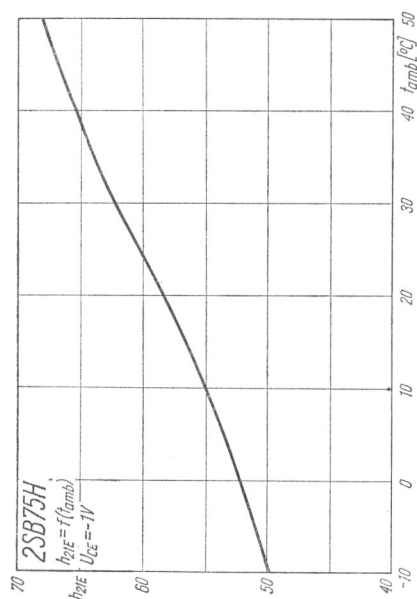
Rys. 1-1221. Charakterystyki wyjściowe



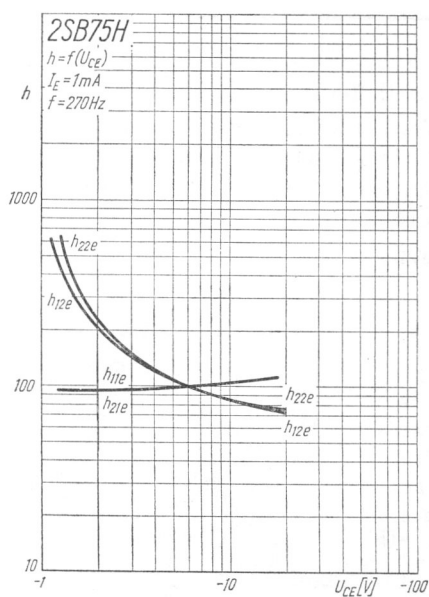
Rys. 1-1222. Zależność prądu zerowego kolektora od temperatury otoczenia



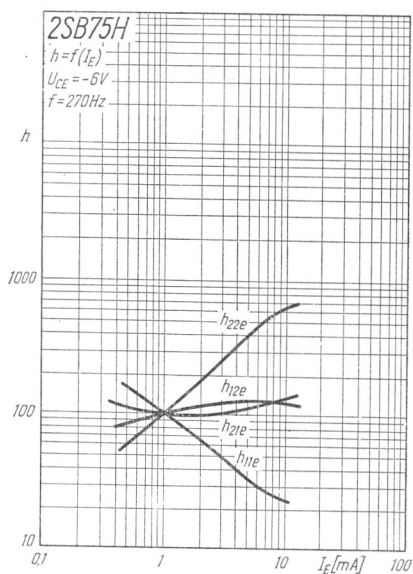
Rys. 1-1223. Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora



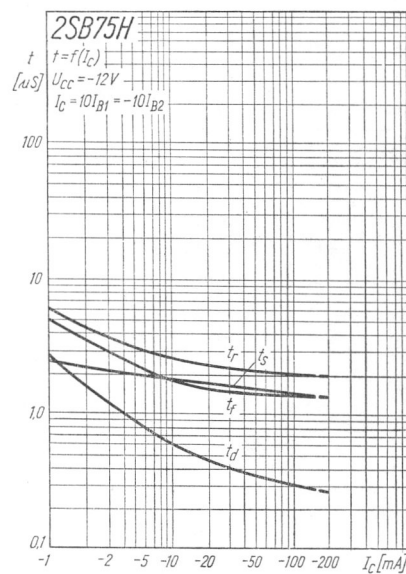
Rys. 1-1224. Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego od temperatury otoczenia



Rys. 1-1225. Zależność parametrów h od napięcia kolektora



Rys. 1-1226. Zależność parametrów h od prądu emitera



Rys. 1-1227. Zależność czasów przełączania od prądu kolektora